для чистого кристалла (рис. 3). Наличие термического отжига после окончания процесса облучения и стабилизация изменений характеристик с ростом дозы, свидетельствующая о достижении стационарной концентрации дефектов, позволяют сделать вывод, что в параэлектрической фазе в кристаллах ДГН параллельно с генерацией дефектов протекает интенсивный процесс их рекомбинации. В результате кристаллы ДГН при комнатной температуре довольно устойчивы к воздействию у-излучения. Сравнение с данными по облучению кристаллов ТГС [6, 8] и КDP [9] показывает, что в параэлектрической фазе кристаллы с водородными связями проявляют большую устойчивость по отношению к воздействию излучения, чем в сегнетоэлектрической фазе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Реріпѕку R., Vedam K., Hoshino S., Okaya Y.//Phys. Rev. 1958. 111, N 2. P. 430—432. [2] Sato S.//J. Phys. Soc. Japan. 1968. 25, N 1. P. 185—201. [3] Игошин И. П.//ФТТ. 1984. 26, № 4. С. 985—988. [4] Тараскин С. А., Струков Б. А., Савилова З. В., Варикаш В. М.//Изв. АН СССР. сер. физ. 1984. 48, № 2. С. 268—271. [5] Струков Б. А., Савилова З. В., Тараскин С. А., Варикаш В. М.//ФТТ. 1986. 28, № 3. С. 733—738. [6] Федорихин В. А. Дис. .. канд. физ.-мат. наук. М., 1981. [7] Леванюк А. П., Осипов В. В., Сигов А. С., Собянин А. С.//ЖЭТФ. 1979. 76, № 1. С. 345—368. [8] Аlemany С., Мепdiola J., Jimenez B., Маигег Е.//Ferroelectrics. 1973. 5, N 1-2. P. 11—15. [9] Пешиков Е. В.//Кристаллография. 1971. 16, № 5.

> Поступила в редакцию 11.12.86

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1987. Т. 28, № 4

УДК 539.213

ПРИРОДА МИКРОГЕТЕРОГЕННОСТИ АМОРФНОЙ СТРУКТУРЫ В СПЛАВЕ Си₃₅Zг₆₅

Г. С. Жданов, Н. А. Хатанова, А. Р. Алтынбаева

(кафедра физики твердого тела)

Изучению структуры аморфных металлических сплавов в последние годы посвящено большое количество работ [1-3], однако полной ясности в этом вопросе все еще нет. Аморфная структура описывается в представлениях топологического и композиционного ближнего норядка [1]. Топологический ближний порядок в расположении атомов характеризуется набором наиболее вероятных межатомных расстояний R_i , определяемых при переходе от интенсивностей и положений диффузных гало к функции радиального распределения. Композиционный ближний порядок можно связать с упорядочением атомов разного сорта внутри локальных областей сплава кластеров, наличие которых приводит к композиционной микрогетерогенности аморфной структуры [4]. В работе [5] методом машинного моделирования было показано и экспериментально подтверждено на сплавах $Fe_{40}N_{18}Mo_4B_{18}$ и $Cu_{50}T_{50}$, что такая кластеров размерами 8—15 Å, независимо от типа упорядочения, приводит к появлечнию на кривых интенсивностей препика в области углов рассеяния до первого интенсивного диффузного гало.

В данной работе проведено изучение особенностей аморфной структуры и природы микрогетерогенности в аморфном сплаве Си₃₅Zг₆₅.

Аморфный сплав Си₃₅Zг₆₅ в виде лент толщиной 50-60 мкм и шириной 2,5 мм был получен методом сверхбыстрой закалки расплава. Рентгеновский анализ проводился фотометодом на молибденовом излучении, монохроматизированном изогнутым кристаллом топаза. Для оценки интенсивностей применялось фотометрирование рентгенограмм на микрофотометре МФ-4. Изучение структуры локальных областей аморфного сплава проводилось методом дифракционной электронной микроскопии.

На рис. 1, а и б приведены рентгенограммы сплава Си₃₅Zr₆₅ после выдерживания при комнатной температуре в течение одного года и трех лет соответственно. После выдерживания в течение одного года на рептгенограмме выявляются диффузные гало с убывающими интенсивностями по мере возрастания угла рассеяния (см. рис. 1, а), что указывает на «рентгеновскую» аморфность сплава. Выдерживание в течение трех лет делает сплав частично кристаллическим, ц на рентгенограмме кроме характерных для аморфной фазы диффузных гало четко выделяются дифракционные линии кристаллической фазы (см. рис. 1, б).

айний кристаллической фазы (см. рис. 1, 0). Согласно диаграмме состояний для системы Cu—Zr [6] в сплаве Cu₃₅Zr₆₅ при кристаллизации должны образоваться две фазы: CuZr₂+CuZr. Но фаза CuZr является высокотемпературной [7] и при 712°C [8] распадается на две: CuZr→CuZr₂+Cu₁₀Zr₇. В аморфном сплаве Cu₃₅Zr₆₅ эти фазы кристаллизуются при 450 и 360°C соответственно [9]. Выявленные нами на рентгенограмме после трех лет выдерживания.

сполиство год. Билинскими принадлежат стабильной кристаллической фазе CuZr₂, имеющей объемноцентрированную тетрагональную решетку с параметреми a=3,22 Å и c=11,18 Å. Фаза Cu₁₀Zr₇ не идентифицируется, так как при небольших ее количествах из

Рис. 1. Рентгенограммы аморфного сплава Си₃₅Zг₆₅ после одного года (а) и трех лет (б) выдерживания при комнатной температуре



трех самых сильных линий две совпадают с линиями от CuZr₇, а третья — с диффузным гало. Ее удалось обнаружить лишь после отжига в течение 2 ч при 550°C, который привел к полной кристаллизации аморфного сплава с образованием



Рис. 2. Микрофотометрическая кривая интенсивности рассеяния рентгеновских лучей от сплава Си₃₅Zr₆₅ после трех лет выдерживания (стрелкой указано положение препика)



Рис. 3. Микрофотометрические кривые рассеяния электронов, пообластей лученные от разных аморфной фазы после трех лет выдерживания сплава Cu35Zr65. Стрелками, направленными вверх, показаны положения первых диффузных гало, стрелками, направположение ленными вниз, ---препика

в основном кристаллической фазы CuZr₂ и фазы Cu₁₀Zr₇ в количестве, достаточном для выявления рентгеновским методом.

Для установления композиционной микрогетерогенности в аморфной фазе (наличие кластеров) после трех лет старения была получена кривая интенсивности *I* рассеяния в области значений sin θ/λ до первого интенсивного диффузного гало (рис. 2), которая позволила выявить препик при sin $\theta/\lambda \sim 0,1$ A⁻¹. Согласно работе [5], такое положение препика соответствует наличню кластеров размерами 10—12 A

Структура аморфного сплава Си₃₅Zr₆₅ после трех лет выдерживания изучалась также методами электронной дифракционной микроскопии. Малое сечение электронного пучка (-2 мкм) позволило регистрировать рассеяние электронов от кристаллической и аморфной фаз отдельно. На микроэлектронограммах обнаружено два близко расположенных диффузных гало, которые соответствуют двум видам топологического ближнего порядка. Результаты фотометрирования таких электронограмм представлены на рис. 3, где в одном случае (a) первое диффузное гало расположено при ($\sin \theta/\lambda$),¹=0,19 A⁻¹, а в другом (6) — при ($\sin \theta/\lambda$),²=0,22 A⁻¹. Отсутствие изображений кристаллов возможных фаз на темнопольных снимках, сформированных каждым из этих двух диффузных гало, показало, что оба они появляются в результате рассеяния от полностью аморфных областей. Кроме того, на обеих кривых рассяяния виден слабо выраженный препик. Полученный результат свидетельствует о сложной природе микрогетерогенности данного аморфного сплава. Помимо композиционной микрогетерогенности данного аморфного сплава. Помимо композиционной микрогетерогенности данного аморфного сплава. Помимо композиционной микрогетерогенности возможных сява типа топологического ближнего порядка, каждый из которых характеризуется своим значением наиболее вероятного межатомного растояния $R_1^{-2} = 3.2$ Å и $R_1^2 = 2.8$ Å, рассчитанных по положениям первых диффузных гало.

Таким образом, естественное старение аморфного сплава Си₃₅Zr₆₅, связанное с очень медленно протекающими процессами кристаллизации, позволило обнаружить в аморфной фазе не только наличие кластеров, но и микрогетерогенность топологического ближнего порядка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Скрышевский А. Ф. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел. М., 1980. [2] Скаков Ю. А., Крапошин В. С.//Итоги науки и техники. Сер. Мсталловедение и термическая обработка. 1980. Т. 13. С. 3—27. [3] Металлические стекла./Под ред. Г. И. Гюнтеродта и Г. Бека. М., 1983. Ч. 1. [4] Хатанова Н. А., Камзеева Е. Е.//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физ. Астрон. 1984. 25, № 4. С. 97—99. [5] Жданов Г. С., Камзеева Е. Е., Хатанова Н. А. Деп. ВИНИТИ № 1070-В86. М., 1986. [6] Полухин В. А., Ватолин Н. А. Моделирование аморфных металлов. М., 1985. [7] Garoche P., Bigot J.//Phys. Rev. 1983. **В28**, N 12. Р. 6885—6895. [8] Carvalho E. M., Harris J. K.//J. Materials Sci. 1980. 15. Р. 1224—1230. [9] Schulz R., Samwer K., Johnson W. L.//J. Non-Crist. Sol. 1984. 61—62. Р. 997—1002.

Поступила в редакцию 05.01.87